

DE10PC3

30V 10A

特長

- SMD
- 超低 $V_F=0.4V$
- 小型大電流容量

Feature

- SMD
- Ultra-Low $V_F=0.4V$
- High I_o Rating・Small-PKG

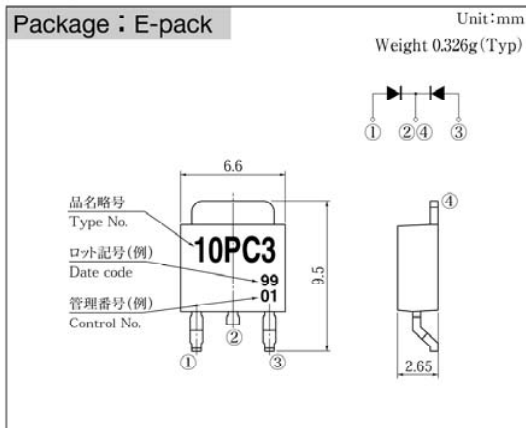
用途

- バッテリー逆接防止
- DC出力OR用
- DC/DCコンバータ
- 携帯電話、パソコン

Main Use

- Reverse connect protection for DC power source
- DC OR-output
- DC/DC Converter
- Mobile phone, PC

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

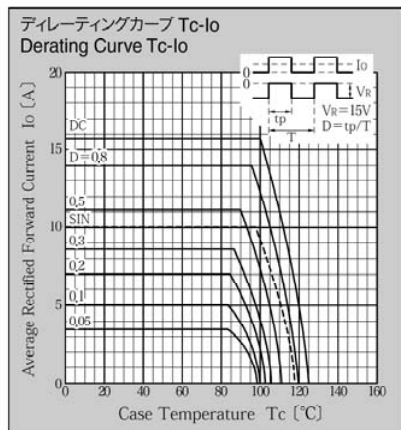
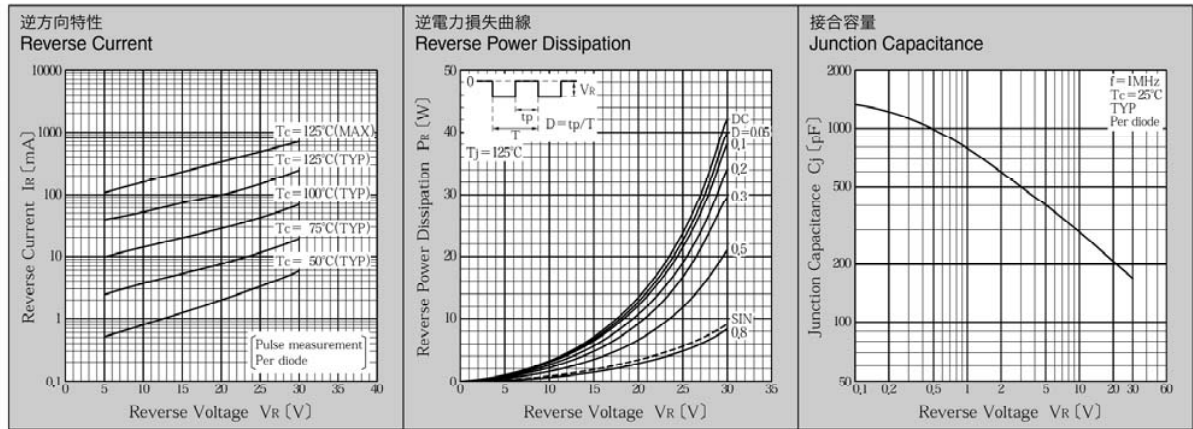
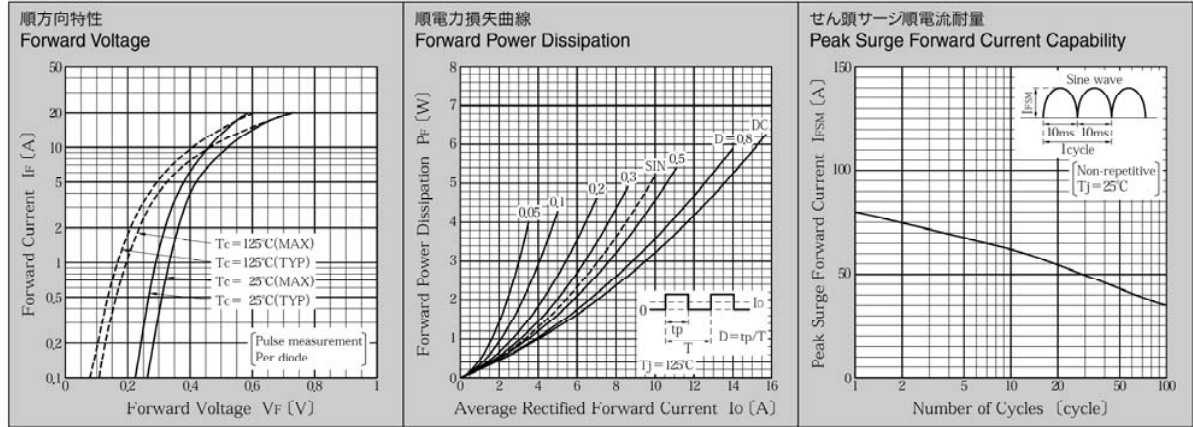
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ C$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DE10PC3	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}			-55~125	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			125	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			30	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V _{RRSM}	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40		35	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _o	50Hz正弦波, 抵抗負荷, 1素子当りの出力電流平均値I _o /2, T _c =97℃ 50Hz sine wave, Resistance load, Per diode I _o /2, T _c =97℃		10	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j =25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j =25℃		80	A

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ C$)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 4 A,	パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.40	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} ,	パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 10	mA
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10V,	1素子当りの規格値 Per diode	TYP 290	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case		MAX 4.0	℃/W

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.
* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っており、Typicalは統計的な実力を表しています。
* Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.